

Rys. 1-111. AD155

Typ tranzystora: tranzystor germanowy

Firma: TELEFUNKEN

Wykonanie: tranzystor germanowy warstwowy *p-n-p* w obudowie metalowej, ciężar max 10 G

Zastosowanie: wzmacniacze mocy i stopnie wyjściowe m.cz., układy przeciwobne

Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$-U_{BE}$		240		mV	przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 50$ mA
$-I_B$		0,42		mA	przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 50$ mA
$-U_{BE}$		400		mV	przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 300$ mA
$-I_B$			7,5	mA	przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 300$ mA
h_{21E}		120			przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 50$ mA
h_{21E}	40				przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 300$ mA
$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$			1,3 ²⁾		przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 50 \div 300$ mA
$\frac{h_{21E1}}{h_{21E2}}$			1,3 ²⁾		przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 0,3 \div 1$ A
$-I_{CB0}$			20	μ A	przy $-U_{CB} = 6$ V
$-I_{CB0}$			30	μ A	przy $-U_{CB} = 25$ V
$-I_{CB0}$			500	μ A	przy $-U_{CB} = 6$ V, $t_{amb} = 70^\circ\text{C}$
$-I_{CES}$			250	μ A	przy $-U_{CB} = 25$ V, $-U_{EB} = 0$
$-I_{EB0}$			30	μ A	przy $-U_{EB} = 12$ V
$-U_{CE0}$	16			V	przy $-I_C = 12$ mA
U_{CER}	25			V	przy $-I_C = 1$ mA, $R_{BE} = 500 \Omega$
f_{h21e}		11		kHz	przy $-U_{CE} = 2$ V, $-I_C = 10$ mA
U_{BE}			10	mV	przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 5$ mA
I_B			25	%	przy $-U_{CE} = 6$ V, $-I_C = 50$ mA
I_B			25	%	przy $-U_{CE} = 1$ V, $-I_C = 300$ mA

Wartości graniczne

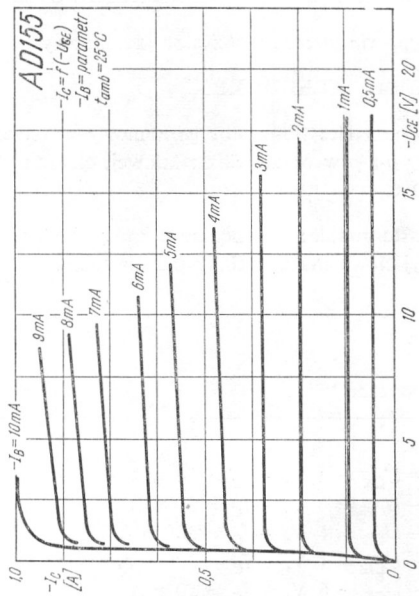
$-U_{CB0}$ max	25	V	$-I_{CM}$ max	2	A
$-U_{CE0}$ max	16	V	t_j max	90	$^\circ\text{C}$
$-U_{CER}$ max	25 ³⁾	V	$R_{th j-c}$ max	7,5	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$-U_{EB0}$ max	12	V	P_{tot} max	6 ⁴⁾	W
$-I_C$ max	1	A	t_{stg}	$-55 \div +75$	$^\circ\text{C}$

¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$

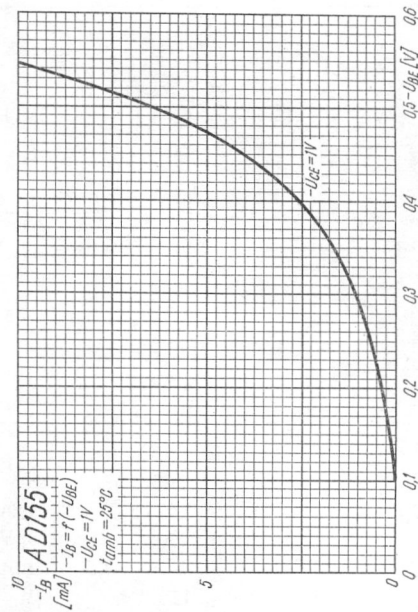
²⁾ warunek dobierania parami

³⁾ $R_{BE} \leq 500 \Omega$

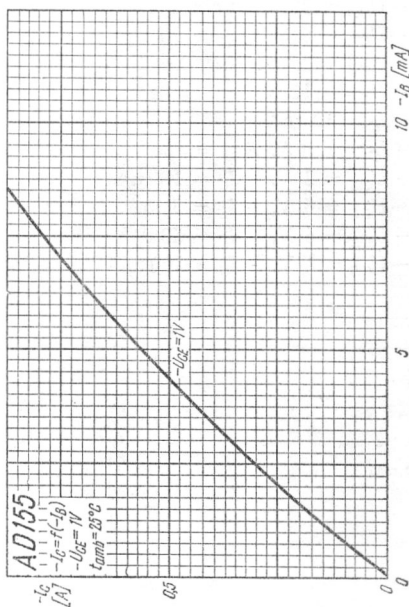
⁴⁾ $t_{case} \leq 45^\circ\text{C}$



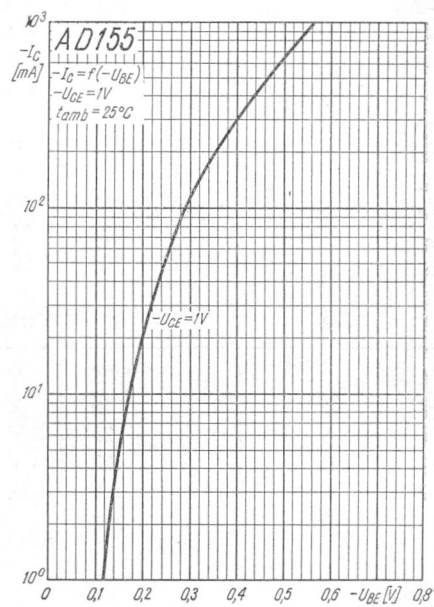
Rys. 1-112. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-113. Charakterystyka wejściowa



Rys. 1-114. Charakterystyka sterowania prądowego



Rys. 1-115. Charakterystyka sterowania napięciowego

